



Акционерное общество
«Экспериментальное
научно-производственное
объединение

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

115409, Москва, Каширское шоссе, 31
тел. (495) 984-67-44, факс (499) 324-04-20

№ К2210/107

от 17 октября 2022 г.

На № 20/3309 от 14.10.2022 г.

[О ведущей организации]

Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
председателю диссертационного совета
24.2.415.01

на базе Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники
д.т.н. профессору Корикову А.М.

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

Уважаемый Анатолий Михайлович!

Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» подтверждает согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе Шевченко Глеба Михайловича «Повышение качества моделирования РЭА за счет использования эквивалентной схемы полупроводникового диода с неквазистатическими эффектами прямого и обратного восстановления» по специальности 2.2.13 – «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Необходимые сведения прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 3 стр. в 1 экз.

Технический директор

А.В. Яненко

Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе Шевченко Глеба Михайловича
на тему «Повышение качества моделирования РЭА за счет использования
эквивалентной схемы полупроводникового диода с неквазистатическими эффектами
прямого и обратного восстановления» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности

2.2.13 – «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	АО «ЭНПО СПЭЛС»
Почтовый индекс, адрес организации	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
Веб-сайт	http://spels.ru
Телефон	+7 (499) 324-04-20, (495) 984-67-44
Адрес электронной почты	office@spels.ru
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. D. I. Sotskov, N. A. Usachev, V. V. Elesin, I. O. Metelkin, N. M. Zhidkov, and A. Y. Nikiforov, "Compact Models for Radiation Hardening by Design of SiGe BiCMOS, GaAs and SOI CMOS Microwave Circuits," in 2021 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), 2021, pp. 1–5, doi: 10.1109/SIBCON50419.2021.9438867. Scopus, ISSN: 2380-6516</p> <p>2. M. S. Gorbunov, N. M. Zhidkov, D. I. Sotskov, A. G. Kuznetsov, V. N. Kotov, V. V. Elesin, and I. A. Selishchev, "Total Ionizing Dose Sensitivity of 180 nm Silicon-on-Insulator Microwave Low-Noise Amplifier," in 2021 IEEE 32nd International Conference on Microelectronics (MIEL), Sep. 2021, pp. 365–368, doi: 10.1109/MIEL52794.2021.9569162. Scopus, ISSN: 2159-1679</p> <p>3. I. A. Selishchev, D. I. Sotskov, A. G. Kuznetsov, N. A. Usachev, V. V. Elesin, V. N. Kotov, and A. O. Balbekov, "SiGe BiCMOS Voltage-Controlled Oscillator and Mixer IP-blocks for the Next-Generation Communication Transceivers," in 2021 IEEE 32nd International Conference on Microelectronics (MIEL), Sep. 2021, pp. 239–242, doi: 10.1109/MIEL52794.2021.9569068. Scopus, ISSN: 2159-1679</p>

4. D. I. Sotskov, V. V. Elesin, A. G. Kuznetsov, N. M. Zhidkov, I. O. Metelkin, K. M. Amburkin, D. M. Amburkin, N. A. Usachev, D. V. Boychenko, and V. V. Elesina, "Displacement Damage Effects Mitigation Approach for Heterojunction Bipolar Transistor Frequency Synthesizers," in *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Nov. 2020, vol. 67, pp. 2396–2404, doi: 10.1109/TNS.2020.3015560.
5. D. Sotskov, V. Elesin, A. Kuznetsov, N. Usachev, N. Zhidkov, and A. Nikiforov, "A single power supply 0.1–3.5 GHz low noise amplifier design using a low cost 0.5 μm d-mode pHEMT process," *Facta universitatis - series: Electronics and Energetics*, vol. 33, pp. 317–326, Jan. 2020, doi: 10.2298/FUEE2002317S.
6. D. I. Sotskov, N. A. Usachev, V. V. Elesin, A. G. Kuznetsov, K. M. Amburkin, G. V. Chukov, M. I. Titova, and N. M. Zidkov, "D-mode pHEMT 0.5 μm Process Characterization to Wide-Band LNA Design," in *2019 IEEE 31st International Conference on Microelectronics (MIEL)*, Sep. 2019, pp. 99–102, doi: 10.1109/MIEL.2019.8889636.
7. Венедиктов М. М., Тарасова Е. А., Боженкина А. Д., Оболенский С. В., Елесин В. В., Чуков Г. В., Метелкин И. О., Кревский М. А., Дюков Д. И., Фелелов А. Г. Анализ поведения неравновесных полупроводниковых структур и СВЧ транзисторов в момент и после импульсного гамма- и гамма-нейтронного облучения / *Физика И Техника Полупроводников*. – 2018. – Т. 52. – № 12. – С. 1414–1420.
8. D. I. Sotskov, V. V. Elesin, K. M. Amburkin, G. N. Nazarova, N. A. Usachev, and A. Y. Nikiforov, "Design and testing issues of a high-speed SOI CMOS dual-modulus prescaler for radiation tolerant frequency synthesizers," in *2017 IEEE 30th International Conference on Microelectronics (MIEL)*, Oct. 2017, pp. 329–332, doi: 10.1109/MIEL.2017.8190132.
9. V. V. Elesin, G. N. Nazarova, N. A. Usachev, and G. V. Chukov, "Small-signal optimization approach to design of microwave signal switch ICs on MOS transistors," *Russian Microelectronics*, vol. 46, no. 5, pp. 365–369, 2017, doi: 10.1134/S106373971705002X.

10. Исследования возможностей отечественной технологии КМОП КНИ 180 нм для создания радиочастотных приемо-передающих БИС космического назначения / Н. А. Усачев, В. В. Елесин, Г. Н. Назарова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 6. – С. 546-558. – DOI 10.24151/1561-5405-2017-22-6-546-558.

Технический директор, к.т.н., доцент




А.В. Яненко

«17» октябре 2022 г.

М.П.

Начальник НТК-1

«17» октября 2022 г.



Н.А. Усачев